

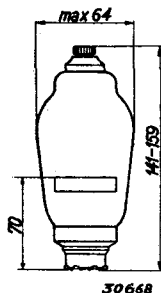
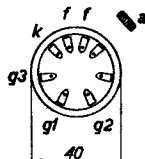
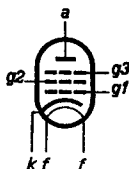


Use : H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstärker
Utilisation : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze : Hoogfrequentversterker
Empleo : Amplificador A.F.

Cathode : Indirectly heated.
Kathode : Indirekt geheizt.
Cathode : à chauffage indirect.
Kathode : Indirect verhit.
Cátodo : caldeado indirectamente.

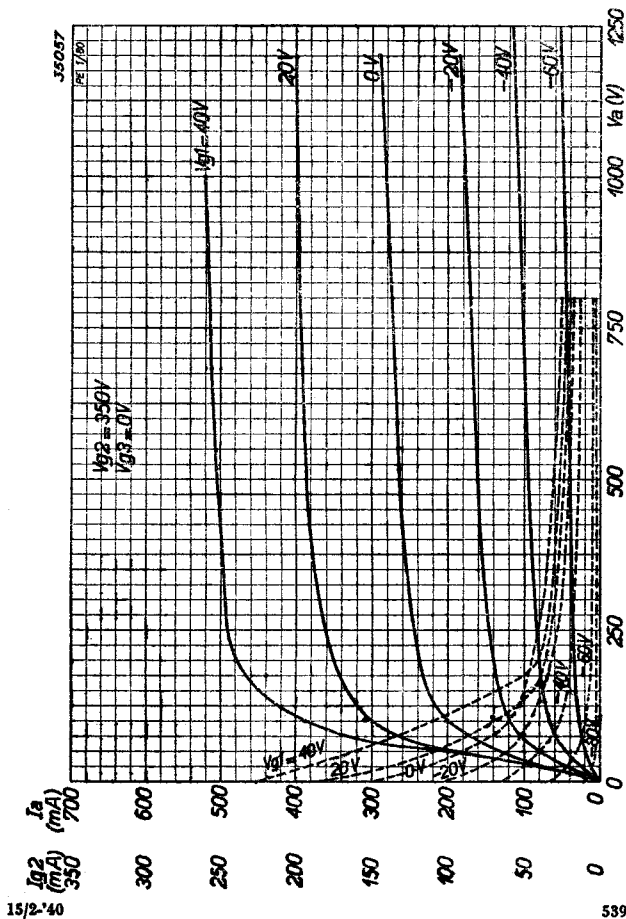
Vf.		≈	12,0	V
If.		≈	0,9	A
Is.		≈	1,0	A
Vg ²		≈ max.	500	V
Wa		≈ max.	35	W
Wat.		≈	45	W
Wg ²		≈ max.	6	W
μg ₁ g ₂		≈	3,9	
S (Va = 1000 V, Vg ² = 200 V, Ia = 40 A)		≈	2,5	mA/V
Ik.		≈ max.	160	mA
Caf		≈	12	pF
Cfg ₁		≈	15	pF
Cag ₁		≈	0,1	pF
Vk-f.		≈ max.	170	V

λ	MHz	Va max
15 m	20	1000 V
5 m	60	625 V



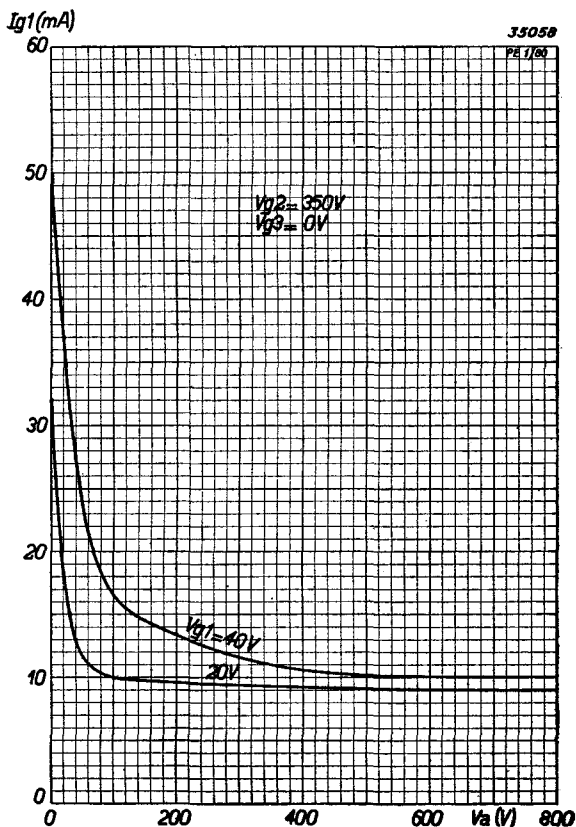


Characteristics :
 Kennlinien :
 Caractéristiques :
 Karakteristieken :
 Características :
 } $I_a - V_a; I_{g2} - V_a$





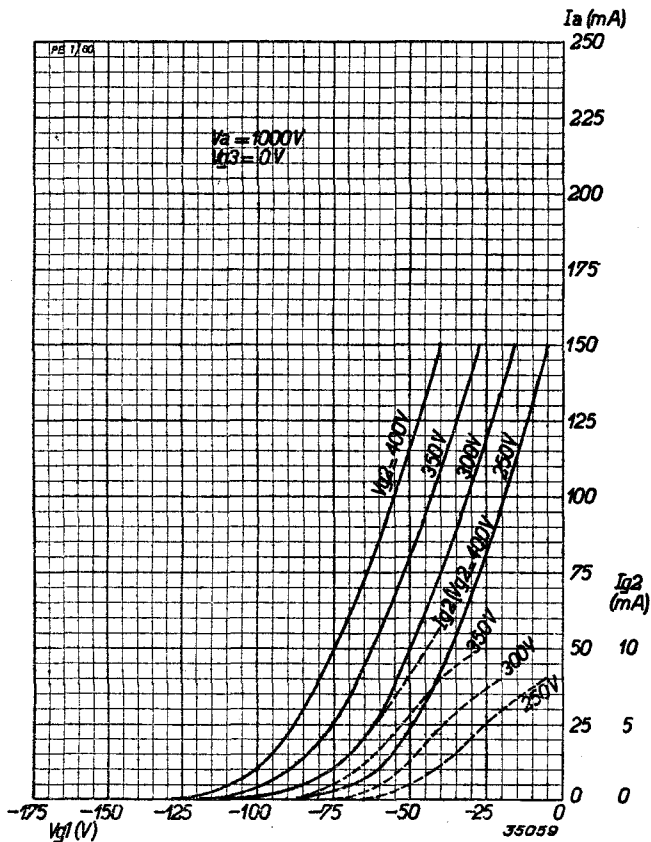
Characteristics :
Kennlinien :
Caractéristiques :
Karakteristieken :
Características :
} $I_{g1}-V_a$





Characteristics :
 Kennlinien :
 Caractéristiques :
 Karakteristieken :
 Características :

$I_a - V_{g_1}$; $I_{g_2} - V_{g_1}$





H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie
H.F. klasse C, telegrafia
A.F. class C, telegrafia

λ	dam 15 hm	dam 15 hm	5m **)	
Va	1000	750	625	V
Vg1	$\approx$ — 170	$\approx$ — 170	$\approx$ — 170	V
Vg2	350	350	350	V
Vg3	0	0	0	V
Ia	120	120	216	mA
Ig1	$\approx$ 6	$\approx$ 6	$\approx$ 20	mA
Ig2	$\approx$ 17	$\approx$ 17	$\approx$ 37,5	mA
Vg1~	$\approx$ 250	$\approx$ 250	$\approx$ 190***)	V
Whf	$\approx$ 1,5	$\approx$ 1,5	$\approx$ 4,0	W
Wi	120	90	135	W
Wa	35	30	70	W
Wg2	6	6	13	W
Wo	85*)	60*)	65*)	W
η	70,5	66,5	48,5	%

H.F. class B, telephony
H.F. Klasse B, Telephonie
H.F. classe B, téléphonie
H.F. klasse B, telefonie
A.F. class B, telefonía

λ	dam 15 hm	5m **)	
Va	1000	625	V
Vg1	$\approx$ — 80	$\approx$ — 100	V
Vg2	350	400	V
Vg3	0	0	V
Ia	48	150	mA
Ig1	$\approx$ 2,5 ¹)	$\approx$ 20 ¹)	mA
Ig2	$\approx$ 4	$\approx$ 16	mA
Vg1~	$\approx$ 60	$\approx$ 95***)	V
Whf	$\approx$ < 0,3 ¹)	$\approx$ 5,5 ¹ *)	W
Wi	48	94	W
Wa	35	70	W
Wg2	1,4	6,4	W
Wo	13*)	24*)	W
η	27	25	%

**) two valves - zwei Röhren - deux tubes - twee buizen - dos válvulas

***) one valve - eine Röhre - un tube - één buis - una válvula

PHILIPS EMISSION

H.F. class C, screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille écran
H.F. klasse C, schermroostermodulatie
A.F. clase C, modulación de rejilla pantalla

λ	dam 15 hm	5m**)	
Va	1000	625	V
Vg1	≈ -170	≈ -170	V
Vg2	250	250	V
Vg3	0	0	V
Ia	53	148	mA
Ig1	$\approx 1,5$	≈ 15	mA
Ig2	$\approx 2,5$	≈ 10	mA
Vg1~	≈ 200	$\approx 220^{***})$	V
Vg2~	$\approx 250^*)$	$\approx 250^*)$	V
Whf	$\approx 0,3^1)$	$\approx 6,5^1)$	W
Wlf	$\approx 5^*)$	$\approx 5,0^*)$	W
Wi	53	93	W
Wa	35	70	W
Wg2	0,6	2,5	W
Wo	18 *)	23 *)	W
η	34	25	%

H.F. class C, suppressor-grid modulation
H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille d'arrêt
H.F. klasse C, vangroostermodulatie
A.F. clase C, modulación de rejilla supresora

λ	dam 15 hm	5m**)	
Va	1000	625	V
Vg1	≈ -170	≈ -100	V
Vg2	300	200	V
Vg3	-140	≈ -75	V
Ia	38	112	mA
Ig1	$\approx 2,4$	≈ 22	mA
Ig2	≈ 20	≈ 57	mA
Ig3	0	0	mA
Vg1~	≈ 200	$\approx 165^{***})$	V
Vg3~	$\approx 280^*)$	$\approx 65^*)$	V
Whf	$\approx 0,5$	$\approx 5,0^*)$	W
Wlf	0	0	W
Wi	38	70	W
Wa	28	54	W
Wg2	6	11,4	W
Wo	10 *)	16 *)	W
η	26,5	23	%

**) two valves - zwei Röhren - deux tubes - twee buizen
dos válvulas

***) one valve - eine Röhre - un tube - één buis - una válvula



H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d'anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
A.F. clase C, modulaci3n de 3nodo

λ	dam 15 hm	
Va	1000	V
Vg1	$\approx$ 170	V
Vg2	275	V
Vg3	0	V
Ia	40	mA
Ig1	$\approx$ 4,5	mA
Ig2	$\approx$ 21	mA
Vg1~	$\approx$ 200	V
Whf	$\approx$ 0,9	W
Wlf	$\approx$ 20 ^{*)}	W
Wi	40	W
Wa	14	W
Wg2	5,8	W
Wo	26 ^{*)}	W
η	65	%

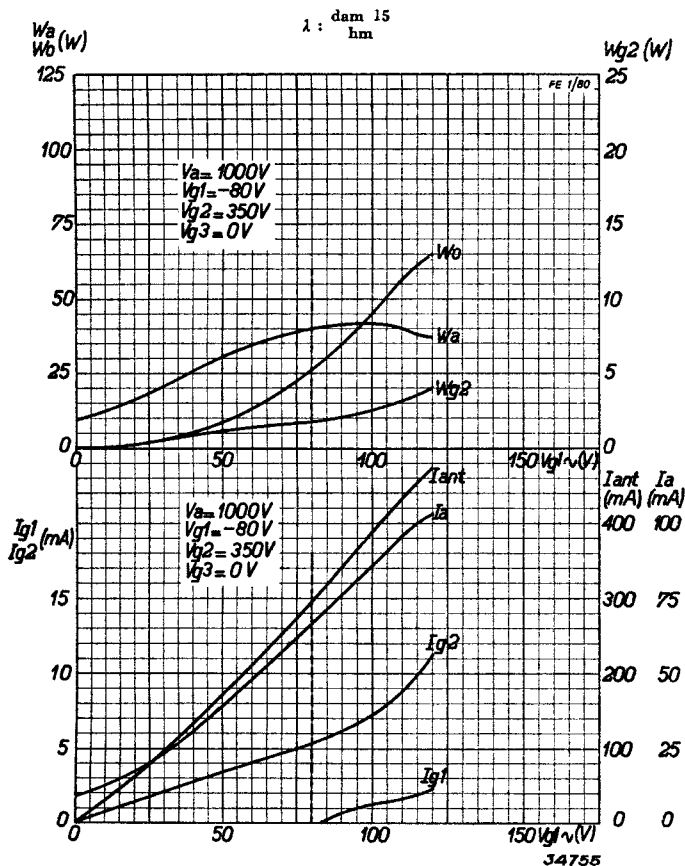
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Anoden- und Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation d'anode et de grille 3cran
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie
A.F. clase C, modulaci3n de 3nodo y de rejilla pantalla

λ	dam 15 hm	
Va	1000	V
Vg1	$\approx$ 170	V
Vg2	250 ^{**))}	V
Vg3	0	V
Ia	84	mA
Ig1	$\approx$ 4	mA
Ig2	$\approx$ 15	mA
Vg1~	$\approx$ 200	V
Vg2~	$\approx$ 250 ^{*)}	V
Whf	$\approx$ 0,8	W
Wlf	$\approx$ 445 ^{*)}	W
Wi	84	W
Wa	24	W
Wg2	3,8	W
Wo	60 ^{*)}	W
η	71,5	%

^{**))} Rg2 = 50,000 Ohm.

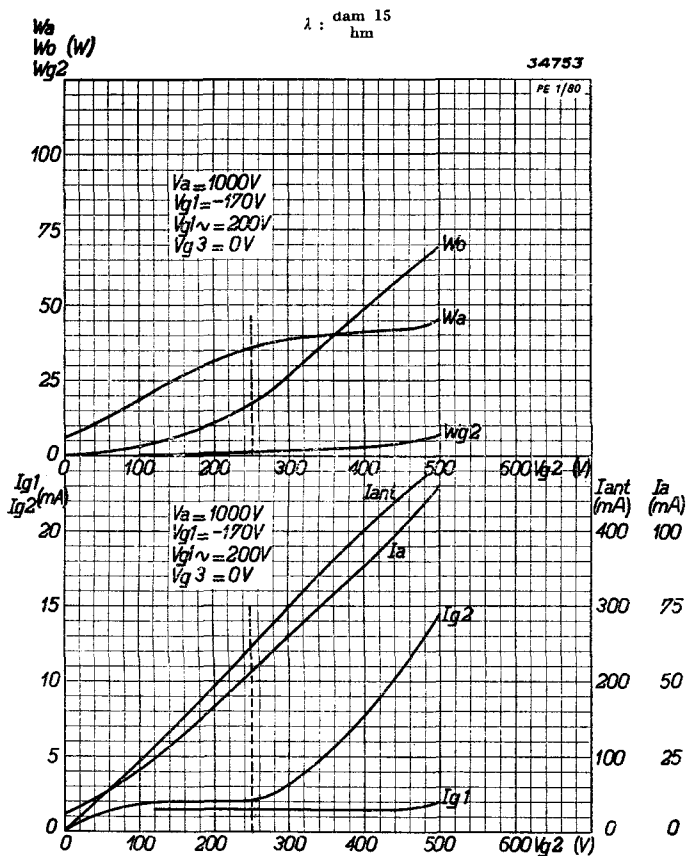


Characteristics : H.F. class B, telephony
 Kennlinien : H.F. Klasse B, Telephonie
 Caracteristiques : H.F. classe B, téléphonie
 Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie
 Características : A.F. clase B, telefonía





Characteristics :	H.F. class C,	screen-grid modulation
Kennlinien :	H.F. Klasse C,	Schirmgittermodulation
Caractéristiques :	H.F. classe C,	modulation de grille écran
Karakteristieken :	H.F. klasse C,	schermroostermodulatie
Características :	A.F. clase C,	modulación de rejilla pantalla





Characteristics : H.F. class C, screen-grid modulation
 Kennlinien : H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
 Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille écran
 Karakteristieken : H.F. klasse C, schermroostermodulatie
 Características : A.F. clase C, modulación de rejilla pantalla

